







Realizzazione di componenti passivi

Francesco Biagini

Ph.D student

francesco.biagini@phd.unipi.it

Dipartimento di ingegneria dell'informazione – Università di Pisa

Centro di ricerca Enrico Piaggio

Discreto VS Integrato

Discreto

Integrato

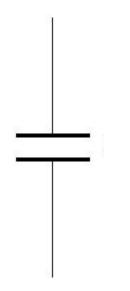
- Alta qualità
- Basse tolleranze
- Area on board
- Manufacturing costs
- Effetti parassiti addizionali

- Bassa qualità
- Alte tolleranze
- Large area on silicon
- No manufacturing costs
- No effetti parassiti addizionali

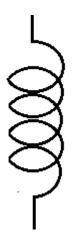
Resistenza



Capacità



Induttanza

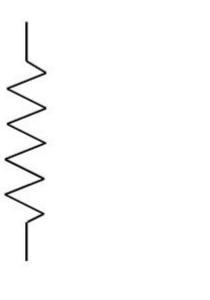


$$R = \frac{\rho t}{S}$$

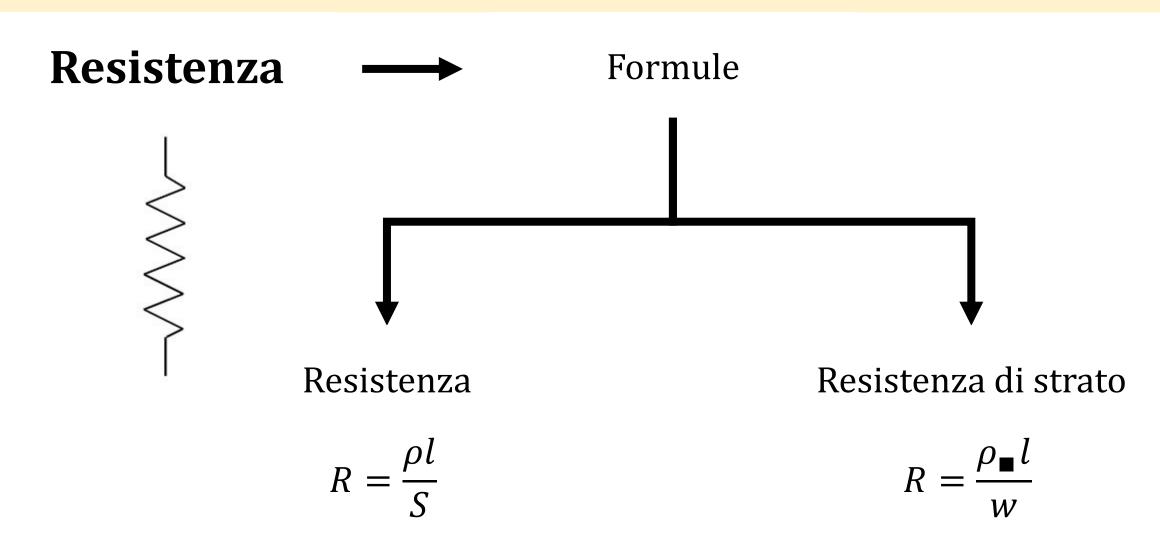
$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d}$$

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 A}{l}$$

Resistenza — Fabbricazione



Strati impiantati o diffusi • Si utilizza silicio (o polisilicio) sufficientemente drogato ► Deposizione di film sottili

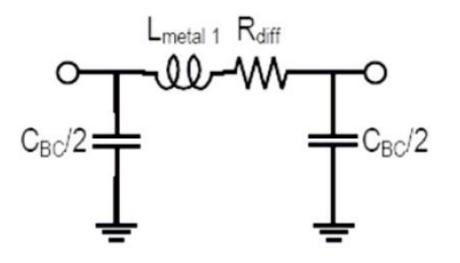


Resistenza



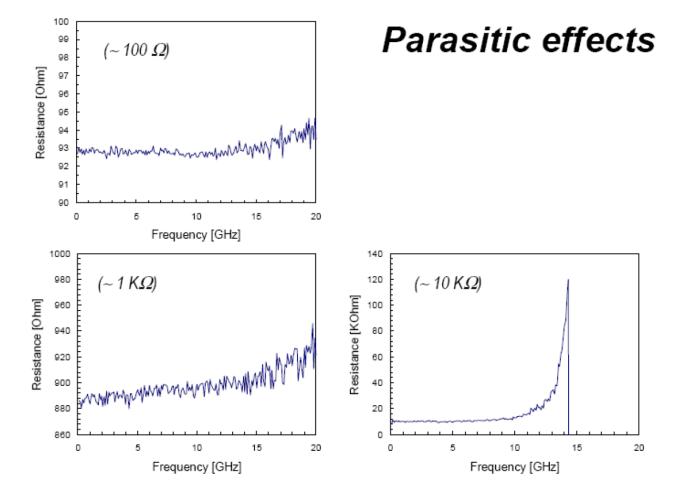
 Oltre alla resistenza è necessario conoscere anche il coefficiente di temperatura ovvero la dipendenza del resistore con la temperatura.

Resistenza

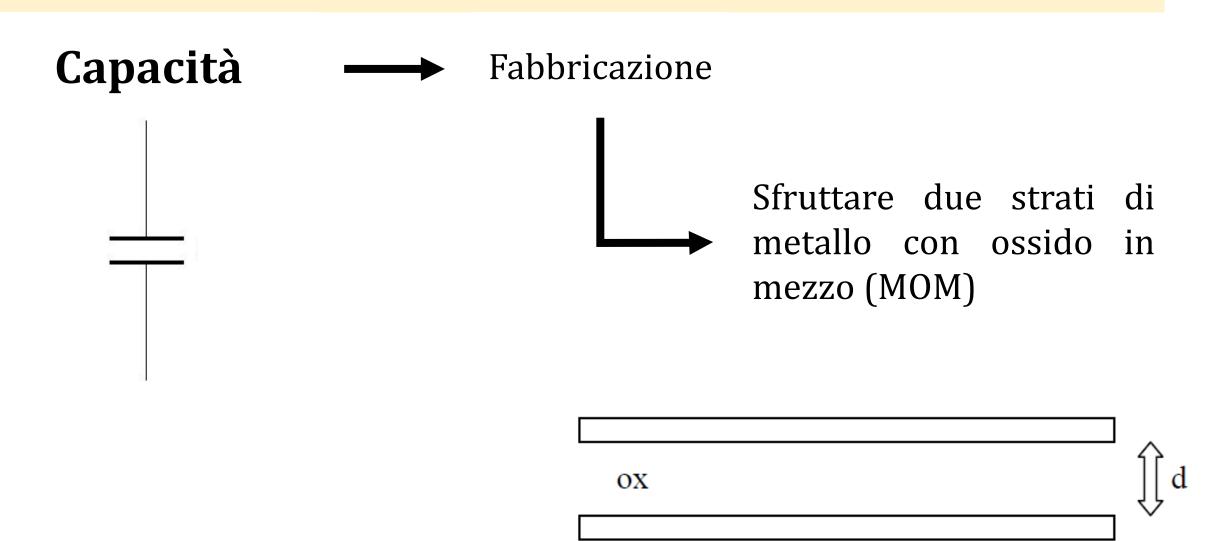


- Effetti parassiti
 - Capacità parassita tra la resistenza e il substrato
 - Effetto induttivo della resistenza in quanto è una sorta di microstriscia
- L'effetto induttivo è minimizzabile andando a squadrare la resistenza
- L'effetto della capacità parassita è legato principalmente all'area occupata dalla resistenza

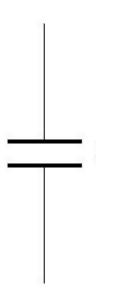
Resistenza



 N.B. La resistenza integrata ad alta frequenza può introdurre degli effetti parassiti determinanti (polo RC modifica la risposta)

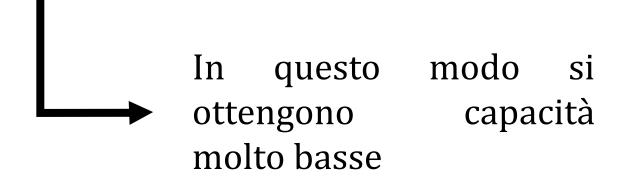


Capacità



$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d}$$

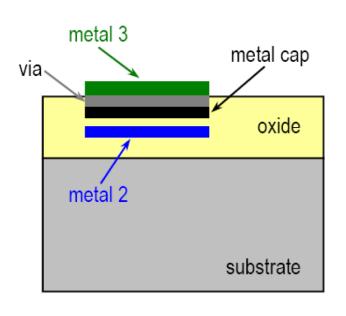
----- Fabbricazione



Osservando la formula, per ottenere capacità più grandi dobbiamo diminuire il lo spessore di ossido.

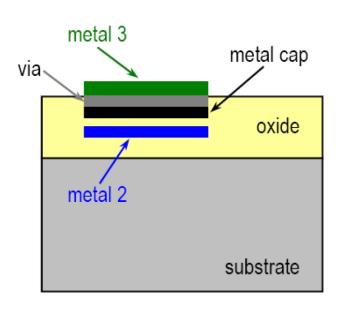
Ma sotto un certo valore non possiamo scendere!

Capacità



- Si utilizza un livello di metallizzazione aggiuntivo: la metal cap.
 - Questo ha uno scopo di definire uno spessore dell'ossido molto piccolo essendo che questo livello è messo tra il livello superiore ed inferiore.
- La capacità che andiamo a considerare è tra la metal cap e il metallo sottostante
- Arriviamo a spessori di ossido di 0,085 micron
- È possibile inoltre utilizzare (attraverso metodi di deposizione) altri materiali dielettrici diversi dall'ossido

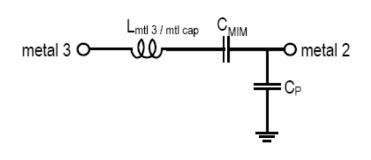
Capacità



- Anche la metal cap deve essere molto fine in quanto deve individuare uno strato di ossido molto fine
 - È quindi problematico andare a tirar fuori un contatto
- La metal cap viene collegato al metal 3 creando un parallelo tra metal cap/via/metal3

Queste capacità integrata si chiamano MIM (metal-insulator-metal)

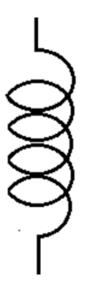
Capacità



Effetti parassiti

- Capacità parassita del livello inferiore verso il substrato (questa capacità è più grande quanto è grande l'area del capacitore)
 - Non c'è una capacità parassita dell'armatura superiore verso il substrato perché il metal3 è schermato rispetto al metal2
- Effetto induttivo perché il capacitore è un pezzo di metal ed ha una sua induttanza

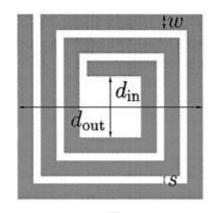
Induttore

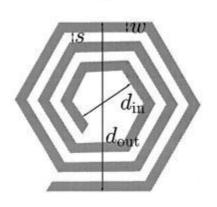


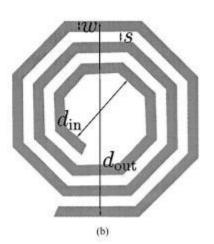


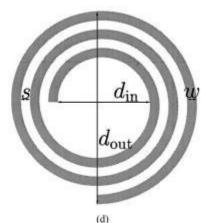
- Realizzati su struttura planare, cioè si sviluppano maggiormente in due dimensioni piuttosto che in tre
- La forma a spirale favorisce l'autoinduttanza

Induttore





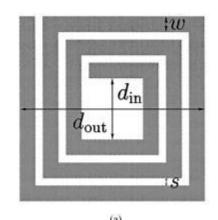


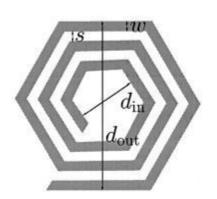


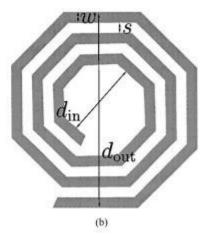
Caratteristiche geometriche:

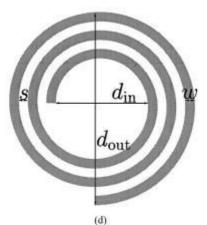
- Forma
- Numero di giri (n)
- Larghezza della pista (w)
- Distanza tra i metal (s)
- Diametro interno (d_{in})
- Diametro esterno (d_{out})
- Fattore di pienezza: $\frac{d_{out}-d_{in}}{d_{in}+d_{out}}$

Induttore





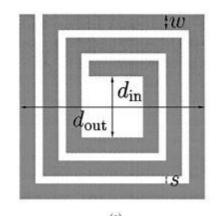


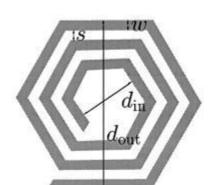


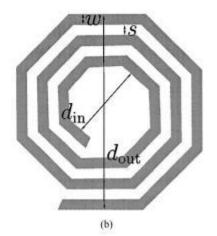
La geometria della spirale è importante perché da essa dipende il valore dell'induttanza a bassa frequenza.

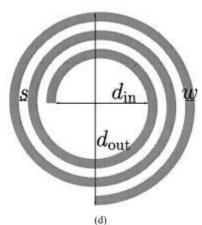
Quale forma è meglio fare???

Induttore





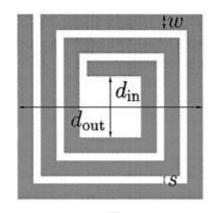


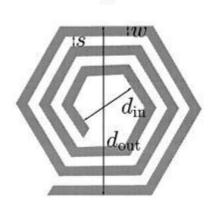


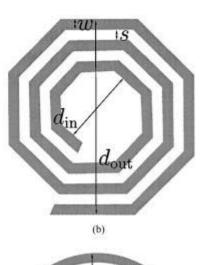
La ragione è legata ad un compromesso tra la caratteristiche ed il costo delle maschere e le prestazioni del componente.

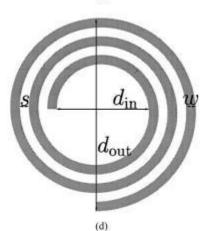
- Le prestazioni crescono quando si va verso forme circolari
- Ma abbiamo un aumento dei costi dovuto alle maschere fotolitografiche che devono avere una risoluzione molto spinta

Induttore









Dei parametri visti solo i primi 5 sono parametri indipendenti

Il fill ratio assume valori tra 0 e 1 (estremi esclusi): se si avvicina a 1 vuol dire che il buco interno è piccolo, viceversa se si avvicina a 0

Induttore

Definizione del fattore di qualità

$$Q = \frac{2\pi E_{STORE}}{E_{DISS}} = \frac{\omega(W_M + W_E)}{P_{DISS}}$$

Definizione generale

Il fattore di qualità di un induttore integrato è indice delle perdite per effetto Joule di cui è affetto l'induttore

$$Q = \frac{Im(Z_{in})}{Re(Z_{in})}$$

Definizione operative

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta \omega_{3dB}}$$

Definizione per oscillatori

$$Q = \frac{\omega_0}{2} \frac{d\phi}{d\omega} \Big|_{\omega_0}$$

Definizione per oscillatori

Induttore

Gli effetti che si manifestano quando si fanno delle piste metalliche vicine su un processo integrato possono essere distinti in due grandi categorie:

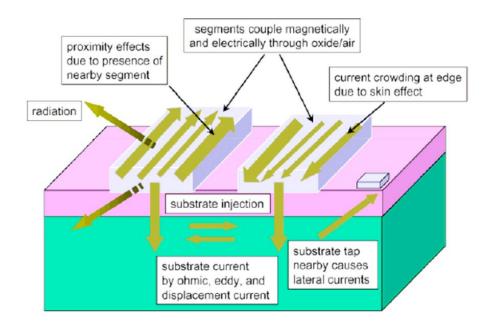
- Perdite di tipo serie
- Perdite di tipo parallelo

Queste comportano la degradazione delle performance del componente

Induttore

- Si manifestano a livello della metallizzazione
- Sono causate dal fatto che ci sono altre piste vicine
 - Effetto pelle (diversa densità di corrente sulla pista) -> Aumento della resistenza ad alte frequenze di lavoro
 - Vi è anche un effetto di prossimità che altera la distribuzione della corrente

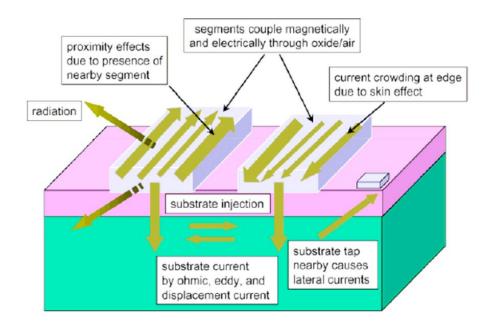
Perdite di tipo serie



Induttore

- Inoltre queste piste si accoppiano in maniera elettromagnetica
 - Oltre che in maniera induttiva si accoppiano in maniera capacitiva (metallo ossido substrato oppure metallo aria metallo oppure metallo ossido metallo)

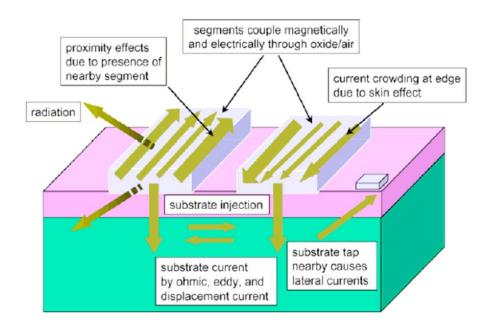
Perdite di tipo serie



Induttore

- Sono principalmente capacità parassite che si formano tra la metallizzazione e il substrato
- Altri effetti possono essere accoppiamenti induttivi con il substrato (in quanto le correnti che scorrono sono variabili nel tempo)
- Effetto radiativo (nelle strutture che noi facciamo non è determinante)

Perdite di tipo parallelo



Induttore

Quindi, non sempre viene utilizzato un sistema a spirale:

